

a 2004 0137

Invenția se referă la tehnologia de producere a semiconductorilor, în special la procedeele de obținere a nanostructurilor semiconductoare.

Esența invenției constă în aceea că procedeul de obținere a nanostructurilor semiconductoare include depunerea unei măști pe una din suprafețele unei plăci semiconductoare, implantarea ionilor, tratarea electrochimică și înlăturarea măștii. Implantarea ionilor se efectuează la o energie a ionilor de cel puțin 30 keV, cu o doză de până la 10^{11} cm⁻², iar tratarea electrochimică se efectuează la trecerea curentului cu o densitate de cel puțin 100 mA/cm².

Revendicări: 1

Figuri: 1